

**Российская конференция
по актуальным проблемам
полупроводниковой фотоэлектроники
(с участием иностранных ученых)
12-16 октября 2015**

ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК-2015

Организатор:



ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
им. А.В. Ржанова СО РАН г. Новосибирск

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ:



Сибирское отделение РАН



Федеральное агентство научных организаций
Российской Федерации



АО "Швабе"



ОАО "Российская электроника"



Новосибирский государственный университет

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Организаторы глубоко признательны за поддержку конференции



Федеральное агентство научных организаций
Российской Федерации



Российский фонд фундаментальных исследований



Группа компаний "Научное Оборудование"



ООО "Вакуумные системы и электроника"



ЗАО "Интек Аналитика"

Сайт конференции: <http://www.isp.nsc.ru/photronics2015/>

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:

Латышев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Асеев А.Л. СО РАН, Новосибирск
Максин С.В. АО "Швабе", Екатеринбург

Зам. председателя:

Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Ракович Н.С. АО "Швабе", Екатеринбург

Ученый секретарь

Каламейцев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены комитета:

Алферов Ж.И. СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
Белоусов Ю.И. ОАО "Корпорация "Комета", Москва
Бетелин В.Б. НИИСИ РАН, Москва
Бочкарёв О.И. ВПК, Москва
Брыкин А.В. ОАО "Российская электроника", Москва
Волков Н.В. ИФ СО РАН, Красноярск
Гуляев Ю.В. ИРЭ РАН, Москва
Доценко В.В. ЗАО "НПФ "Микран", Томск
Жуков А.Е. СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
Зверев А.В. ОАО "Российская электроника", Москва
Иванов В.П. ФГУП "НПО "ГИПО", Казань
Ивченко Е.Л. ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Исюк В.И. ОАО НЗПП с ОКБ, Новосибирск
Крайлюк А.Д. АО "Концерн "Вега", Москва
Красильник З.Ф. ИФМ РАН, Н.Новгород
Красников Г.Я. ОАО "НИИМЭ и Микрон", Зеленоград
Кукушкин И.В. ИФТТ РАН, Черноголовка
Кулипанов Г.Н. ИЯФ СО РАН, Новосибирск
Мантуров Д.В. Минпромторг, Москва
Мизеров М.Н. НТЦ МЭ РАН, Санкт-Петербург
Мисник В.П. ОАО "Корпорация "Комета", Москва
Неизвестный И.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск
Никитов С.А. ИРЭ РАН, Москва
Овсяк В.Н. ИФП СО РАН, Новосибирск
Орликовский А.А. ФТИ РАН, Москва
Пархоменко Ю.Н. АО "ГИРЕДМЕТ", Москва
Резнев А.А. Москва

Потапов А.В. Минпромторг, Москва
Салихов С.В. Минобрнауки, Москва
Сауров А.Н. ИНМЭ РАН, Москва
Сибельдин Н.Н. ФИ РАН, Москва
Сигов А.С. МИРЭА, Москва
Сизов Ф.Ф. ИФП НАН Украины, Киев
Солдатенков В.А. ОАО "НПО Геофизика-НВ", Москва
Тарасов А.П. ОАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева",
Красногорск
Тарасов В.В. ОАО ЦНИИ "Циклон", Москва
Терехов А.С. ИФП СО РАН, Новосибирск
Филачев А.М. ГУП "НПО "Орион", Москва
Хохлов Д.Р. МГУ, Москва
Хохлов С.В. Минпромторг, Москва
Чаплик А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Шалагин А.М. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя:

Грибков В.П. ИФП СО РАН, Новосибирск
Дворецкий С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Федоринин В.Н. Филиал ИФП СО РАН "КТИПМ",
Новосибирск

Ученый секретарь

Ильина Л.А. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены оргкомитета:

Бетеров И.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Войцеховский А.В. ТГУ, Томск
Гайслер В.А. НГТУ, Новосибирск
Глухов А.В. ОАО НЗПП с ОКБ, Новосибирск
Гугучкин В.И. ЗАО "Экран-Оптические системы",
Новосибирск
Девяткин П.Т. ИФП СО РАН, Новосибирск
Ивонин И.В. ТГУ, Томск
Паршин А.С. СибГАУ, Красноярск
Ковчавцев А.П. ИФП СО РАН, Новосибирск
Корчак В.Ю. Секция прикладных проблем
при Президиуме РАН, Москва

Котюков М.М. ФАНО России, Москва
Локтионов В.И. ОАО "Катод", Новосибирск
Максимов Е.М. Москва
Паулиш А.Г. Филиал ИФП СО РАН "КТИПМ",
Новосибирск
Пономаренко В.П. ГУП "НПО "Орион", Москва
Потатуркин О.И. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск
Принц В.Я. ИФП СО РАН, Новосибирск
Пчеляков О.П. ИФП СО РАН, Новосибирск
Рассохин В.А. ОАО "Швабе Оборона и Защита",
Новосибирск
Рубцова Н.Н. ИФП СО РАН, Новосибирск
Сидоров Ю.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск
Рябцев И.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Скубневский Э.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Торопов А.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Федорук М.П. НГУ, Новосибирск
Шлишевский В.Б. СГУГиТ, Новосибирск
Якушев М.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Малый зал Дома ученых

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

15⁰⁰ – 18⁰⁰ Регистрация участников конференции

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

1-е заседание *Председатель - А.В. Латышев*

10⁰⁰ – 10¹⁵ Открытие совещания. Вступительное слово директора ИФП СО РАН **А.В. Латышева**

10¹⁵ – 10³⁵ **И.Д. Бураков^{1,2}, В.П. Пономаренко^{1,3}, А.М. Филачев^{1,2}**, Космическая фотосенсорика (**приглашенный доклад**)
¹АО "НПО "Орион", Москва
²МГТУ МИРЭА, Москва
³МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный, МО

10³⁵ – 10⁵⁵ **Г.Н. Кулипанов**, Потенциальные возможности Новосибирского лазера на свободных электронах для исследований в области длин волн (270 - 5) микрон (**приглашенный доклад**)
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск

10⁵⁵ - 11¹⁵ **Ю.Н. Кульчин¹, О.Б. Витрик¹, А.А. Кучмижак¹**, Лазерная нанолитография (**приглашенный доклад**)
¹Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток

11¹⁵ - 11³⁵ **Д.В. Брунев, В.В. Васильев, В.С. Варавин, А.В. Вишняков, С.А. Дворецкий, И.В. Марчишин, Н.Н. Михайлов, И.В. Сабина, Г.Ю. Сидоров, Ю.Г. Сидоров, М.В. Якушев, А.В. Латышев**, Фотоприемные устройства на основе гетероэпитаксиальных структур теллурида кадмия и ртути (**приглашенный доклад**)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

2-е заседание *Председатель - Ю.Н.Кульчин*

11⁵⁰ - 12¹⁰ **А.Е. Жуков¹, М.В. Максимов^{1,2}, Ю.М. Шерняков^{2,1}, Н.В. Крыжановская¹, Ф.И. Зубов¹, А.С. Паюсов^{1,2}, Ю.В. Кудашова¹, Е.С. Семенова³, Л.В. Асрян⁴**, Асимметричные барьерные слои и их применение в полупроводниковых лазерах (**приглашенный доклад**)
¹Санкт-Петербургский Академический университет, Санкт-Петербург
²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
³DTU Fotonik, Technical University of Denmark, Kgs. Lyngby, Denmark
⁴Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA

12¹⁰ - 12³⁰ **В.М. Устинов**, Быстродействующие вертикально-излучающие лазеры (**приглашенный доклад**)
ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

ОБЕД (12³⁰ - 14⁰⁰)

14⁰⁰ - 15⁰⁰ Стендовая сессия (доклады с 1 по 25).

3-е заседание *Председатель - А.В. Двуреченский*

15⁰⁰ - 15²⁰ **А.А. Андронов, Е.П. Додин, Ю.Н. Ноздрин, Д.И. Зинченко¹; М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк, А.А. Падалица²; В.А. Беляков, И.В. Ладенков, А.Г. Фефелов³**, Стимулированное излучение на переходах между лестницами Ванье-Штарка в полупроводниковых сверхрешетках (**приглашенный доклад**)
¹ИФМРАН, Н.Новгород
²ФГУП "Салют", Н.Новгород
³"Сигм-Плюс" Москва

15²⁰ - 15⁴⁰ **С.В. Гапоненко**, Перспективы коллоидной оптоэлектроники (**приглашенный доклад**)
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

15⁴⁰ - 16⁰⁰ **Б.И. Шапиро**, Высокоорганизованные J-агрегаты полиметиновых красителей как сенсоры в фотоэлектронике (**приглашенный доклад**)
Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва

16⁰⁰ - 16¹⁵ **В.В. Шелковников, Н.А. Орлова, И.Ю. Каргаполова**, Синтез функциональных блоков для нелинейно оптических хромофоров
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

4-е заседание

Председатель - Г.Н. Кулипанов

16³⁰ - 16⁵⁰ **В.С. Павельев^{1,2}, А.Н. Агафонов¹, Н.А. Винокуров^{3,4}, Б.О. Володкин¹, Б.А. Князев^{3,4}, Г.Н. Кулипанов³, В.А. Соيفер^{1,2}, К.Н. Тукмаков¹, Ю.Ю. Чопорова^{3,4}**, Формирование лазерных пучков терагерцового диапазона на основе применения дифракционной компьютерной оптики (**приглашенный доклад**)
¹Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
²Институт систем обработки изображений РАН
³Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
⁴Новосибирский государственный университет

16⁵⁰ - 17¹⁰ **W. Knap^{1,2}, D. But¹, N. Dyakonova¹, D. Coquillat¹, M. Vitiello³, S.D. Ganichev⁴, M. Sypek⁵**, Terahertz Detectors Based on Plasma Oscillations in Nanometer Field Effect Transistors (**приглашенный доклад**)
¹Charles Coulomb Laboratory, CNRS & Montpellier University, Montpellier (France)
²High Pressure Institute Polish Academy of Sciences Warsaw (Poland)
³NEST, Istituto Nanoscienze - CNR and Scuola Normale Superiore Pisa (Italy)
⁴Terahertz Center, University of Regensburg, Regensburg, (Germany)
⁵Optical Information Processing Laboratory, Warsaw University of Technology, (Poland)

17¹⁰ - 17²⁵ **А.Д. Буравлев^{1,3}, И.А. Мустафин^{1,2}, В.Н. Трухин^{1,2}, Г.Э. Цырлин^{1,3}, J.P. Kakko⁴, T. Huhtio⁴, H. Lipsanen⁴**, Эффективная генерация терагерцового излучения в периодическом массиве полупроводниковых нитевидных нанокристаллах на основе GaAs
¹ФТИ им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург
²НИУ ИТМО, Санкт-Петербург
³СПб АУ РАН, Санкт-Петербург
⁴Micronova, Aalto University, Aalto, Finland

17²⁵ - 17⁴⁰ **С.А. Кузнецов^{1,2}, А.Г. Паулиш^{1,2}, В.Н. Федоринин¹**, Оптоэлектронные системы терагерцового и субтерагерцового диапазонов частот электромагнитного излучения
¹Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск
²НГУ, Новосибирск

17⁴⁰ - 17⁵⁵ **А.Э. Климов¹, В.В. Кубарев², В.Н. Шумский¹**, Уровни захвата и терагерцовые фотоэффекты в PbSnTe:In
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, СО РАН Новосибирск

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

5-е заседание

Председатель - А.Е. Жуков

09⁰⁰ - 09²⁰ **С.Г. Егорова¹, А.В. Галеева¹, В.И. Черничкин¹, Л.И. Рябова², Е.П. Скипетров¹, М.Е. Тамм², Л.В. Яшина², С.Н. Данилов³, С.Д. Ганичев³, Д.Р. Хохлов^{1,4}**, Терагерцовое зондирование поверхностных состояний в топологических изоляторах (**приглашенный доклад**)
¹Физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва
²Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
³Faculty of Physics, University of Regensburg, Regensburg, Germany.
⁴Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Москва

- 09²⁰ - 09⁴⁰ **К.Д. Мынбаев**^{1,2}, Н.Л. Баженов¹, Н.Н. Михайлов³, М.В. Якушев³, В.С. Варавин³, С.А. Дворецкий³, Фотолюминесцентная характеристика эпитаксиальных слоев твердых растворов CdHgTe (**приглашенный доклад**)
¹ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
²Университет ИТМО, Санкт-Петербург
³ИФП СО РАН, Новосибирск
- 09⁴⁰ - 10⁰⁰ **В.А. Володин**^{1,2}, М.П. Гамбарян^{1,3}, Г.К. Кривякин^{1,3}, Г.Н. Камаев¹, С.А. Кочубей¹, А.Г. Черков^{1,3}, В.И. Вдовин^{1,3}, М. Vergnat⁴, J. Stuchlik⁵, А.В. Двуреченский^{1,2}, Светоизлучающие нанокристаллы Si, Ge и GeSi в различных матрицах: формирование, структурные и оптические свойства (**приглашенный доклад**)
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
³Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
⁴Université de Lorraine, Institut Jean Lamour, Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France
⁵Institute of Physics ASCR, Praha, Czech Republic
- 10⁰⁰ - 10¹⁵ **А.А. Блошкин**^{1,2}, А.И. Якимов¹, В.В. Кириенко¹, В.А. Тимофеев¹, В.А. Армбристер¹, А.В. Двуреченский^{1,2}, А.И. Никифоров¹, Гетероструктуры Ge/Si с квантовыми точками Ge для фотоприемников среднего ИК-диапазона
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
- 10¹⁵ - 10³⁰ А.Е. Гайдук, С.Н. Речкунов, В.А. Селезнёв, Е.А. Злобина, **В.Я. Принц**, Многослойные поляризаторы ИК-диапазона большой площади
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

6-е заседание

Председатель - С.В. Гапоненко

- 10⁴⁵ - 11⁰⁵ **А.В. Войцеховский**¹, Н.Х. Талипов², Воздействие мощного импульсного ИК излучения на свойства гетероэпитаксиальных структур HgCdTe (**приглашенный доклад**)
¹Томский государственный университет, Томск
²Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, Москва
- 11⁰⁵ - 11²⁰ Е.А. Емельянов¹, А.В. Васев¹, М.А. Путьято¹, И.Б. Чистохин¹, В.В. Румянцев², С.В. Морозов², Б.Р. Семягин¹, А.П. Василенко¹, А.К. Гутаковский¹, **В.В. Преображенский**¹, Влияние температуры роста на структурные и оптические свойства сверхрешеток GaSb/InAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии
¹ИФП СО РАН, Новосибирск
²ИФМРАН, Нижний Новгород
- 11²⁰ - 11³⁵ **Л.К. Орлов**, Н.С. Волкова, М.Л. Орлов, Т.О. Мищенко, Туннельная спектроскопия электронных состояний в гетерокомпозициях InAs/GaAs с массивами квантовых точек
ИФМРАН, ННГУ, НГТУ, Н.Новгород
- 11³⁵ - 11⁵⁰ **И.И. Ижнин**^{1,2}, Е.И. Фищич¹, А.В. Войцеховский², А.Г. Коротаев², А.Ю. Бончик³, Г.В. Савицкий³, В.С. Варавин⁴, С.А. Дворецкий⁴, Н.Н. Михайлов⁴, М.В. Якушев⁴, К.Д. Мынбаев^{5,6}, Релаксация и долговременная стабильность МЛЭ CdHgTe n+-n-структур, сформированных ионным травлением
¹Научно-производственное предприятие "Карат", Львов
²Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
³ИППММ им. Я.С. Пидстригача НАН Украины, Львов
⁴ИФП СО РАН, Новосибирск
⁵ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург
⁶Университет ИТМО С.-Петербург

11⁵⁰ - 12⁰⁵ **И.Е. Тыщенко¹**, Л.Л. Дзюбина¹, А.Г. Черков², В.А. Володин^{1,2}, В.П. Попов¹, Ионно-лучевой синтез и свойства нанокристаллов InSb в структурах кремний-на-изоляторе
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск

12⁰⁵ - 12²⁰ **В.А. Швеиц^{1,2}**, Е.В. Спесивцев¹, И.А. Азаров¹, С.В. Рыхлицкий¹, Н.Н. Михайлов¹, М.В. Якушев¹, В.Д. Кузьмин¹, Ю.Г. Сидоров¹, С.А. Дворецкий^{1,3}, Метод эллипсометрии в технологии процессов молекулярно-лучевой эпитаксии кадмий-ртуть-теллура
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
³Томский государственный университет, Томск

12²⁰ - 12³⁵ Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, Е.М. Труханов, И.В. Сабина, И.Д. Лошкарев, **А.В. Колесников**, М.В. Якушев, Дислокации в гетероэпитаксиальных структурах CdHgTe на подложках ориентации (013) и возможности снижения их плотности
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск

ОБЕД (12³⁵-14⁰⁰)

14⁰⁰ - 15⁰⁰ Стендовая сессия (доклады с 26 по 59).

7-е заседание **Председатель - И.Д. Бурлаков**

15⁰⁰ - 15²⁰ **A.Piotrowski**, Status of mid and long infrared detectors at Vigo System (**приглашенный доклад**)
VIGO System S.A., Ożarów Mazowiecki

15²⁰ - 15³⁵ И.Д. Бурлаков¹, **К.О. Болтарь¹**, П.В. Власов¹, А.А. Лопухин¹, В.А. Соловьев², А.Н. Семенов², Б.Я. Мельцер²,

Т.А. Комиссарова², Т.В. Львова², С.В. Иванов², МФПУ на основе эпитаксиальных структур антимонида индия
¹АО "НПО "Орион", Москва
²Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

15³⁵ - 15⁵⁰ **Д.Г. Есаев**, А.П. Савченко, В.А. Фатеев, И.В. Марчишин, М.А. Демьяненко, А.И. Торопов, А.К. Калагин, Н.А. Валишева, Н.Р. Вицина, Матричные фотоприемники на основе квантовых ям GaAs/AlGaAs форматом 384×288 и 640×512
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

15⁵⁰ - 16⁰⁵ В.М. Базовкин¹, Н.А. Валишева¹, В.С. Варавин¹, В.В. Васильев¹, В.М. Гайлес², А.А. Гузев¹, С.А. Дворецкий¹, А.П. Ковчавцев¹, И.И. Ли¹, Д.В. Марин¹, Ю.С. Макаров¹, В.Г. Половинкин¹, И.В. Сабина¹, Ю.Г. Сидоров¹, Г.Ю. Сидоров¹, Д.В. Фромичев², А.В. Царенко¹, **М.В. Якушев¹**, Новое поколение ИК фотоприемников на основе КРТ, работающих при повышенных температурах
¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск
²АО "НПП "Восток", Новосибирск

16⁰⁵ - 16²⁰ **Г.Ю. Сидоров**, И.В. Сабина, В.В. Васильев, Ю.Г. Сидоров, И.В. Марчишин, А.В. Предин, М.В. Якушев, В.М. Базовкин, В.Г. Половинкин, Создание матричных фотоприемников на основе ГЭС КРТ МЛЭ на длины волн 3-5 и 8-10 мкм форматом до 1024×1024
Институт физики полупроводников СО РАН им. А.В.Ржанова, Новосибирск

16²⁰ - 16³⁵ **O.I. Semenova¹**, N.A.Yeryukov¹, Zhiyong Li², Thin films of PECVD silicon nitride for nanophotonic application
¹Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk
²Institute of Semiconductors CAS, Beijing, China

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

8-е заседание**Председатель - А.Н. Шалунов**

- 16⁵⁰ - 17¹⁰ **Ю.Н. Вольхин**, Радиофотоника: прошлое, настоящее, будущее (**приглашенный доклад**)
ОАО "ЦКБА", Россия, Омск
- 17¹⁰ - 17³⁰ **С.А. Малышев¹, А.Л. Чиж¹, К.Б. Микитчук¹, А.А. Тептеев², А.С. Шуленков²**, Мощный высокоскоростной фотодиод Шоттки для устройств и систем радиофотоники (**приглашенный доклад**)
¹Институт физики НАН Беларуси, Минск
²ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", Минск
- 17³⁰ - 17⁵⁰ **А.И. Плеханов**, Высокоскоростные оптические модуляторы на основе нелинейно-оптических полимеров (**приглашенный доклад**)
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск
- 17⁵⁰ - 18⁰⁵ **И.М. Гаджиев, М.С. Буяло, Е.Л. Портной**, Увеличение мощности модуляции добротности в лазерах с квантовыми ямами под воздействием эффекта Штарка
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
- 18⁰⁵ - 18²⁰ **М.Г. Кистенева¹, М.В. Бородин¹, В.В. Щербина¹, С.М. Шандаров¹, В.М. Шандаров¹, А.С. Акрестина¹, Е.С. Худякова¹, В.М. Лисицын², С.А. Степанов², А.А. Колегов³**, Волноводные и оптические характеристики эпитаксиальных структур GaN/InGaN - сапфир
¹Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
²Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
³Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. У.И. Забабахина, Снежинск
- 18²⁰ - 18³⁵ **М.Д. Шарков¹, М.Е. Бойко¹, А.В. Бобыль¹, А.М. Бойко¹, Е.М. Ершенко¹, Я.В. Зубавичус², С.Г. Конников¹**, Изучение структуры и фазового состава синтезированных образ-

цов фосфата лития-железа и титаната лития - материалов для литий-ионных аккумуляторов
¹Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
²НИЦ "Курчатовский институт", Москва

19⁰⁰ - Банкет**ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ****9-е заседание****Председатель - В.М. Устинов**

- 09⁰⁰ - 09²⁰ **В.И. Гавриленко**, Лазеры дальнего ИК диапазона на основе узкозонных полупроводников и гетероструктур с квантовыми ямами (**приглашенный доклад**)
Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
- 09²⁰ - 09⁴⁰ **В. А. Гайслер^{1,2,3}**, Разработка неклассических излучателей на основе полупроводниковых квантовых точек (**приглашенный доклад**)
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
³Новосибирский государственный университет, Новосибирск
- 09⁴⁰ - 09⁵⁵ **Н.В. Крыжановская¹, Ю.В. Кудашова¹, Э.И. Моисеев¹, А.Е. Жуков^{1,3}, М.В. Максимов^{1,2,3}, М.М. Кулагина², С.И. Трошков², Ю.М. Задиранов², А.А. Липовский^{1,3}**, Инжекционные микродисковые лазеры с активной областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs, работающие до 100°C
¹Академический университет, Санкт-Петербург,
²Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
³Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Санкт-Петербург

09⁵⁵ - 10¹⁰ **А.В. Шевлягин¹**, Н.Г. Галкин¹, А.К. Гутаковский², Т.С. Шамирзаев², Высокоэффективный Si ИК светодиод со встроенными нанокристаллитами β -FeSi₂, работающий при комнатной температуре
¹Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток
²Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

10¹⁰ - 10²⁵ **С.В. Морозов^{1,2}**, В.В. Румянцев¹, А.А. Дубинов^{1,2}, В.Я. Алёшкин^{1,2}, А.М. Кадыков^{1,2}, М.А. Фадеев^{1,2}, Н.Н. Михайлов³, С.А. Дворецкий³ и В.И. Гавриленко^{1,2}, Длинноволновая фотолюминесценция и стимулированное излучение в структурах на основе твердых растворов HgCdTe
¹ИФМРАН, Нижний Новгород
²ННГУ им.Н.И.Лобачевского, Н.Новгород
³ИФП СО РАН, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

10-е заседание **Председатель - А.А. Андронов**

10⁴⁰ - 10⁵⁵ **О.Е. Терещенко^{1,2}**, В.А. Голяшов^{1,2}, И.Б. Чистохин¹, Т.С. Шамирзаев^{1,2}, А.С. Ярошевич¹, А.А. Родионов¹, И.А. ДЕРЕБЕЗОВ¹, В.А. Гайслер¹, А.К. Бакаров^{1,2}, Д.В. Дмитриев¹, А.И. Торопов¹, И.И. Мараховка³, А.В. Коптилов³, Н.В. Кислых³, Изучение инжекции спин-поляризованных электронов в гетероструктуры A₃B₅ методом поляризованной катодолуминесценции
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
³ЗАО "ЭКРАН-ФЭП", Новосибирск

10⁵⁵ - 11¹⁰ Л.Н. Сафронов, В.А. Антонов, С.Н. Подлесный, **В.П. Попов**, Управление спектром излучения алмазов с NV центрами
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

11¹⁰ - 11²⁵ **А.А. Лямкина¹**, С.П. Мощенко¹, А.К. Бакаров¹, А.И. Торопов¹, К. Шрамль², М. Канибер², Д. Финли², Экситон-плазмонное взаимодействие в системе с InAs/AlGaAs КТ и литографическими анизотропными наноантеннами
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Институт Вальтера Шоттки, Технический Университет Мюнхена, Гархинг, Германия

11²⁵ - 11⁴⁰ **Д.С. Абрамкин¹**, К.М. Румынин¹, А.К. Бакаров¹, А.К. Гутаковский¹, О.В. Кибис², Т.С. Шамирзаев¹, Кристаллическое строение и энергетический спектр III-Sb/AlAs самоорганизованных квантовых точек
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²НГТУ, Новосибирск

11⁴⁰ - 11⁵⁵ Г.М. Борисов^{1,2}, В.Г. Гольдорт¹, Д.В. Ледовских¹, А. А. Ковалёв¹, М.Н. Пулято¹, В.В. Преображенский¹, **Н.Н. Рубцова¹**, Б. Р. Семягин¹, В.Е. Кисель³, А.С. Руденков³, Н.В. Кулешов³, А.А. Павлюк⁴, Полупроводниковые зеркала с насыщающимся поглощением для фемтосекундных лазеров ближнего инфракрасного диапазона
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
³НИИ оптических материалов и технологий БНТУ, Минск, Беларусь
⁴Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

11⁵⁵ - 12¹⁰ **А.В. Царев^{1,2}**, Интерферометр Маха-Цендера, слабо чувствительный к технологическим ошибкам изготовления
¹Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск

ОБЕД (12¹⁰ - 14⁰⁰)

14⁰⁰ - 15⁰⁰ Стендовая сессия (доклады с 60 по 95)
15⁰⁰ - 18³⁰ Экскурсия

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

11-е заседание *Председатель - В.И. Гавриленко*

09⁰⁰ - 09²⁰ **С.Г. Тиходеев**. Оптические свойства кирально-модулированных фотонных структур (*приглашенный доклад*)
Институт общей физики им. А.М. Прохорова, Москва

09²⁰ - 09⁴⁰ **Н.В. Волков¹, А.С. Тарасов¹, М.В. Рауцкий¹, А.В. Лукьяненко^{1,2}, С.Н. Варнаков^{1,2}, С. Г. Овчинников¹**. Эффекты гигантского магнитосопротивления в гибридных структурах ферромагнетик/полупроводник, индуцированные оптическим излучением (*приглашенный доклад*)
¹*ИФ СО РАН, Красноярск*
²*СибГАУ, Красноярск*

09⁴⁰ - 10⁰⁰ **А.Г. Милёхин^{1,2}, Л.Л. Свешникова¹, Т.А. Дуда¹, Е.Е. Родякина^{1,2}, С.А. Кузнецов², V.M. Dzhanan³, А.В. Латышев^{1,2}, D.R.T. Zahn³**. Комбинационное рассеяние света и инфракрасное поглощение полупроводниковыми нанокристаллами на плазмонных структурах (*приглашенный доклад*)
¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*
²*Новосибирский Государственный университет, Новосибирск*
³*Semiconductor Physics, Technische Universität Chemnitz, D-09107, Chemnitz*

10⁰⁰ - 10¹⁵ **А.Г. Журавлев^{1,2}, А.С. Романов^{1,2}, В.Л. Альперович^{1,2}**. Эмиссия горячих и термализованных фотоэлектронов из р-GaAs(Cs,O) с положительным и отрицательным сродством
¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск*
³*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск*

10¹⁵ - 10³⁰ **А.В. Трифанов¹, Д.Ю. Протасов², В.Я. Костюченко³, С.А. Дворецкий²**. Определение подвижности неосновных электронов в р-Cd_{0.22}Hg_{0.78}Te при температуре жидкого азота
¹*Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск*
²*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

10³⁰ - 10⁴⁵ **А.А. Гисматулин¹, В.А. Володин^{1,2}, Г.Н. Камаев¹, С.Г. Черкова¹, А.Г. Черков²**. Формирование и оптические свойства многослойных наноструктур Si/SiO₂
¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*
²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск*

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

12-е заседание *Председатель - В.Н.Шумский*

11⁰⁰ - 11²⁰ **О.П. Пчеляков, В.В. Преображенский, М.А. Путьято, А.С. Дерябин, Л.В. Соколов, А.И. Никифоров, А.К. Гутаковский, Е.М. Труханов, Н.А. Паханов, А.П. Василенко, И.Д. Лошкарёв, Д.И. Феклин, В.М. Владимиров*, А.С. Паршин****. Проблемы создания высокоэффективных солнечных преобразователей для космических аппаратов (*приглашенный доклад*)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
^{*}*НПФ "Электрон", Красноярск*
^{**}*СибГАУ, Красноярск*

11²⁰ - 11³⁵ **Н.Г. Галкин¹, К.Н. Галкин¹, И.М. Чернев¹, А.В. Шевлягин¹, Radek Fajgar², The Ha Stuchlikova³, Jiri Stuchlik³, Zdenek Remes^{3,4}**. Новый подход к формированию солнечных

батарей на основе аморфного гидрогенизированного кремния и полупроводниковых силицидов

¹Институт автоматизации и процессов управления ДВО РАН, Владивосток

²Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, Praha, Czech Republic

³Institute of Physics of the ASCR, Praha, Czech Republic

⁴Czech Technical University in Prague, Faculty of Biomedical Engineering, Kladno, Czech Republic

- 11³⁵ - 11⁵⁰ П.Н. Брунков^{1,2}, Н.Д. Ильинская¹, С.А. Карандашев¹, Н.Г. Карпункина³, А.А. Лавров¹, **Б.А. Матвеев¹**, М.А. Ременный¹, Н.М. Стусь¹, А.А. Усикова¹. Фотодиоды на основе ДГС InAs/InAsSb_{0,1}/InAsSbP ($\lambda_{0,1}=5.2$ мкм), работающие в температурном диапазоне 50-300 К
¹ФТИ им.А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
²Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург
³ООО "ИоффеЛЕД", Санкт-Петербург

- 11⁵⁰ - 12⁰⁵ **А.Н. Бельтюков¹**, Р.Г. Валеев¹, А.И. Чукавин¹, Д.И. Петухов², В.М. Ветошкин¹. Разработка электролюминесцентных излучателей оптического диапазона на базе полупроводниковых наноконструкций ZnS:Cu@Al₂O₃
¹Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск
²Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова, Москва

- 12⁰⁵ - 12²⁰ **А.П. Ковчавцев¹**, В.Г. Кеслер, А.А. Гузев, А.Е. Настовьяк. А.В. Царенко, З.В. Панова. Температурные зависимости адмиттанса InAs-МОП структур со сверхтонким окислом
ИФП СО РАН, Новосибирск

- 12²⁰ - 12³⁵ **В.В. Карпов¹**, А.В. Филатов, Е.В. Сусов, Н.С. Кузнецов. Фоторезисторы из гетероэпитаксиальных структур CdHgTe на спектральный диапазон 8-12 мкм
ОАО "Швабе-Фотосистемы", Москва

ОБЕД (12³⁵ - 14⁰⁰)

13-е заседание

Председатель - В.Н. Овсяк

- 14⁰⁰ - 14²⁰ **Б.А. Князев^{1,2}**, В.В. Герасимов^{1,2}, М.А. Демьяненко³, Д.Г. Есаев³, И.В. Марчишин³, А.А. Никитин², Ю.Ю. Чопорова^{1,2}. Матричные болометрические приемники в исследованиях на терагерцовом лазере на свободных электронах (**приглашенный доклад**)
¹Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
³Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

- 14²⁰ - 14³⁵ **Д.В. Бородин^{1,2}**, Ю.В. Осипов^{1,2}, В.В. Васильев². КМОП фотоприемник видимого диапазона формата 1,3 Мп
¹ОАО "НПП "Пульсар", Москва
²ООО "РТК Инпекс", Мытищи

- 14³⁵ - 14⁵⁰ Г.Е. Журов, Е.А. Крапивко, И.И. Кремис, **В.Н. Федоринин**, М.Ю. Цивинский, С.М. Чурилов, П.И. Шапор, К.П. Шатунов. Состояние развития тепловизионных модулей и приборов в Филиале ИФП СО РАН "КТИПМ" Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

- 14⁵⁰ - 15⁰⁵ В.В. Карпов¹, В.П. Астахов¹, М.Е. Козырев¹, **В.Ф. Чижик¹**, В.И. Петренко¹, В.И. Семенов¹, Д.В. Бородин², Ю.В. Осипов², В.В. Васильев². Спектральные характеристики фотодиодов КМОП матричного фотоприемника видимого диапазона формата 256×256 элементов
¹ОАО "Швабе-Фотосистемы", Москва
²ООО "РТК Инпекс", Мытищи

- 15⁰⁵ - 15²⁰ А.А. Емельянов¹, А.Г. Викулов¹, С.В. Гамзинов¹, А.В. Долгих¹, И.И. Гольдбергер¹, В.И. Локтионов¹, А.А. Мармалюк², А.А. Падалица², А.Ю. Андреев², А.В. Мазалов², В.В. Бакин³, Д.В. Горшков^{3,4}, С.Н. Косолобов³, С.А. Рожков^{3,4}, Г.Э. Шайблер³, **А.С. Терехов³**. Фотоприемники с полупроводниковыми ОЭС - фотокатодами на спектральные диапазоны в интервале 200 - 1100 нм

¹ОАО "Катод", Новосибирск
²ОАО "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха", Москва
³ИФП СО РАН, Новосибирск
⁴НГУ, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

14-е заседание **Председатель - В.Н. Федоринин**

15³⁵ - 15⁵⁵ **С.М. Борзов¹, А.В. Голицын², Б.С. Долговесов¹, О.И. Потатуркин¹, М.Н. Филиппов¹.** Информационное обеспечение систем наблюдения распределенных роботизированных комплексов (**приглашенный доклад**)
¹Институт автоматизации и электрометрии СО РАН
²Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

15⁵⁵ - 16¹⁰ **А.И. Чукавин¹, Р.Г. Валеев¹, А.Н. Бельтюков¹, В.В. Кривенцов², А.Л. Тригуб³.** Исследование влияния локальной атомной и электронной структуры нанокмполитов ZnS:Cu@Al₂O₃ на их фотоэлектрические свойства
¹Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск
²Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
³НИЦ Курчатовский институт, Москва

16¹⁰ - 16²⁵ **А.В. Аржанников, И.А. Иванов, С.А. Кузнецов, В.Ф. Скляр.** Частотно-селективная диагностическая система для абсолютных измерений электромагнитного излучения в интервале от миллиметровых волн до терагерцового излучения
Новосибирский государственный университет
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск

16²⁵ - 16⁴⁰ **Э.Г. Косцов, С.Д. Иванов.** Элемент неохлаждаемой мегапиксельной тепловизионной матрицы на основе тонких пироэлектрических пленок
Институт автоматизации и электрометрии СО РАН, Новосибирск

16⁴⁰ - 16⁵⁵ **А. В. Голицын.** Электроуправляемый широкоспектральный объектив с жидкостными линзами
Филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск

18⁰⁰ ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

**Экскурсия в ИФП СО РАН
и Филиал ИФП СО РАН "КТИПМ"
по предварительной записи**

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Методы и технологии получения наноструктурированных материалов для перспективных фотоприемников ИК-диапазона

1. **С.В. Рыхлицкий, Е.В. Спесивцев, В.А. Швеи, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов.** Методы и средства эллипсометрической диагностики материалов и структур нанофотозлектроники
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

2. **Е.А. Емельянов, А.В. Васев, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко, А.А. Команов А.К., Гутаковский, М. А. Пулято, В. В. Преображенский.** Получение гетероструктур InAsSb методом МЛЭ с применением различных молекулярных форм As
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

3. **А.К. Бакаров^{1,2}, К. С. Журавлев², А.И. Торопов¹, Т.А. Левцова¹, Н.А. Валишева¹, А.С. Кожухов^{1,2}, Д.В. Щеглов^{1,2}.** ДБЭО исследования начальных стадий роста слоев InSb при МЛЭ
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск

4. **М.А. Василенко^{1,2}, И.Г. Неизвестный^{1,2}, Н.Л. Шварц^{1,2}.** Условия формирования нанокристаллов и наноконцев GaAs методом капельной эпитаксии (Монте-Карло моделирование)
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирск

5. **А.Е. Гайдук**, С.Н. Речкунов, В.А. Селезнёв, В.Я. Принц. Нанорешеточный световой фильтр большой площади, изготовленный с помощью наноимпринт-литографии
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

6. **Д. В. Дмитриев**, А. М. Гилинский, А. И. Торопов, К. С. Журавлёв, Синтез гетероструктур InAlAs согласованных с подложкой InP методом МЛЭ для высокочувствительных фотодиодов
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

7. **А.Ю. Игуменов¹**, А.С. Паршин¹, Ю.Л. Михлин², О.П. Пчеляков³, В.С. Жигалов⁴. Электронная спектроскопия дисилицида железа
¹СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярск
²ИХХТ СО РАН, Красноярск
³Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
⁴ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск

8. В.А. Пилипович, В.Б. Залесский, **А.И. Конойко**, В.М. Кравченко, Термооптический преобразователь на базе микрорезонатора Фабри-Перо
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Беларусь, Минск

9. А.В. Войцеховский, А.П. Коханенко, **К.А. Лозовой**. Зависимость критической толщины перехода по Странскому-Крастанову в системе $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}/\text{Si}$ от температуры и состава
Томский государственный университет, Томск

10. **И.А. Милёхин¹**, Е.Е. Родякина^{1,2}, А.В. Латышев^{1,2}, С.А. Кузнецов², Л.Л. Свешинова¹, А.Г. Милёхин^{1,2}. Локализованные поверхностные плазмоны в массивах наноантенн Au
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²НГУ, Новосибирск

11. **С.В. Рыхлицкий**, Е.В. Спесивцев, С.А. Дулин. Спектральный рефлектометрический комплекс для технологического контроля оптических материалов фотоники по параметру объёмного рассеяния
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

12. **О.И. Подкопаев¹**, Т.О. Павлюк¹, А.Ф. Шиманский², Н.О. Голубовская². Выращивание малодислокационных монокристаллов германия
¹АО "Германий", Красноярск
²Сибирский федеральный университет, Красноярск

13. **В.А. Швец^{1,2}**, В.Г. Ремесник¹, Н.Н. Михайлов¹, В.С. Варавин¹, П.Л. Смирнов¹, С.А. Дворецкий^{1,3}. Исследование оптическими методами слоёв КРТ, имплантированных ионами В⁺
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский государственный университет, Новосибирск
³Томский государственный университет, Томск

14. **А.В. Артамонов¹**, В.П. Астахов¹, И.Б. Варлашов², В.В. Карпов¹, П.В. Митасов². Химический состав анодных окисных плёнок InAs и электрофизические параметры МДП-структур на их основе
¹ОАО "Швабе-Фотосистемы", Москва
²Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва

15. **А.Х. Мухамметоразова**. Электрические свойства наноструктурированных барьеров Шоттки Pt-окисел-n-GaAs
Институт солнечной энергии Академии Наук Туркменистана, Ашхабад

16. **К.А. Конфедератова^{1,2}**, Е.Е. Родякина^{1,2}. Формирование однородных по размеру наноструктур методом электронно-лучевой литографии: методы коррекции эффектов близости
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск

17. **Н.Н. Михайлов**, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, В.Г. Ремесник, Ю.Г. Сидоров. Влияние защитного покрытия CdTe на электрофизические параметры эпитаксиальных плёнок $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

18. А.Н. Акимов, **Д.В. Ищенко**, Н.С. Пацин, С.П. Супрун, В.Н. Шерстякова, В.Н. Шумский. Структуры n-i-n, p-i-p, n-i-p на основе эпитаксиальных плёнок PbSnTe:In: изготовление и свойства
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

Терагерцовое излучение: полупроводниковые приемники и излучатели

19. **П.С. Загубисало**¹, **А.Г. Паулиш**¹, **С.А. Кузнецов**². Моделирование теплофизических процессов в конвертере субтерагерцового излучения в инфракрасное

¹Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

²НГУ, Новосибирск

20. **А.Г. Паулиш**, **П.С. Загубисало**. Оптимизация свойств фотоупругого элемента для пьезооптических датчиков деформаций
Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

21. **С.Л. Микерин**¹, **А.И. Плеханов**¹, **А.Э. Симанчук**¹, **А.В. Якиманский**². Полингованные нелинейно-оптические полимеры для генерации широкополосного терагерцового излучения

ИАиЭ СО РАН, Новосибирск

²Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург

22. **М.А. Демьяненко**¹, **Д.Г. Есаев**¹, **А.И. Козлов**¹, **А.Р. Новоселов**², **В.Н. Овсяк**¹. Мозаичные инфракрасные и терагерцовые фотоприемники обзорно-панорамного формата: системный подход

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

²Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

23. **А.А. Алтухов**¹, **Ю.В. Гуляев**², **Н.Х. Талипов**², **В.С. Феценко**¹, **В.А. Шепелев**¹, **Г.В. Чучева**². Комплексированный ИК+УФ интегральный матричный фотоприёмник на основе микроболометров и SiC

¹ООО ПТЦ "УралАлмазИнвест", Москва

²Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Фрязино

24. **А.А. Алтухов**¹, **Ю.В. Гуляев**², **Н.Х. Талипов**², **Г.В. Чучева**². Высокочувствительный планарный матричный фотоприемник на основе алмаза для УФ-канала комплексированной инфракрасной оптико-электронной системы

¹ООО ПТЦ "УралАлмазИнвест", Москва

²Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Фрязино

25. **И.А. Азаров**^{1,3}, **В.А. Швеиц**^{1,3}, **Б.А. Князев**^{2,3}, **Ю.Ю. Чопорова**^{2,3}, **С.В. Рыхлицкий**¹, **В.Ю. Проконьев**^{1,3}. Эллипсометрический комплекс терагерцового диапазона

¹ИФП СО РАН, Новосибирск

²ИЯФ СО РАН, Новосибирск

³НГУ, Новосибирск

Фотоэлектрические явления в полупроводниковых структурах

26. **А.С. Перин**, **В.Ю. Рябчёнок**, **В.М. Шандаров**. Влияние пироэлектрического эффекта на характеристики линейной и нелинейной дифракции световых пучков в кристалле ниобата лития

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

27. **А.В. Вишняков**, **В.А. Стучинский**, **Д.В. Брунёв**, **А.В. Зверев**, **С.А. Дворецкий**. Определение объёмной и локальных длин диффузии носителей заряда в фоточувствительном слое матричных ИК-приёмников фотодиодного типа на основе материала кадмий-ртуть-теллур

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

28. **Е.В. Богданов**, **Е.П. Кубашевский**, **Н.Я. Минина**. Переключение поляризационных мод излучения лазерных диодов на основе Zn AlGaAs/GaAsP/p AlGaAs при внешних напряжениях

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва

29. **М.В. Боев**¹, **В.М. Ковалев**^{1,2}, **А.В. Чаплик**^{1,3}. Генерация акустических волн двумерным экситонным газом

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

²НГТУ, Новосибирск

³НГУ, Новосибирск

30. **В.С. Варавин**, **Д.В. Марин**, **М.В. Якушев**. Рекомбинация носителей заряда в структурах Cd_{0,3}Hg_{0,7}Te/Si(013)

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

31. *Т.В. Малин¹, А.М. Гишинский¹, В.Г. Мансуров¹, Д.Ю. Протасов¹, А.В. Кожухов¹, Е.Б. Якимов², О.В. Кибис³, К.С. Журавлев¹*. Возрастные диффузионной длины неосновных носителей заряда в твердых растворах $Al_xGa_{1-x}N$ ($x=0\dots 0,1$), выращенных методом аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²ИПТМ РАН, Черногоровка
³НГТУ, Новосибирск
32. *В.В. Атучин^{1,2}, В.Н. Кручинин¹, С.В. Рыхлицкий¹, В.А. Кочубей^{1,2}, Л.Д. Покровский^{1,2}, С.У. Рамапа³*. Оптические свойства высокоупорядоченных тонких пленок V_2O_5
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
²НГУ, Новосибирск
³Department of Mechanical Engineering, University of Texas at El Paso, El Paso, Texas, USA
33. *В.В. Малютин-Бронская¹, А.В. Семченко², В.Б. Залесский¹*. Фотоэлектрические свойства пленок оксида цинка легированные редкоземельными металлами
¹Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Беларусь, Минск
²Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Гомель
34. *С.Г. Нефёдов, В.В. Павлов, Р.В. Писарев*. Анизотропия сверхбыстрого оптического эффекта Керра в GaAs
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
35. *Ю.Г. Пейсахович, А.А. Штыгашев*. Матричные элементы электрон-фотонного взаимодействия в кристаллической решетке конечной длины
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
36. *К.М. Румынин, Д.С. Абрамкин, А.К. Бакаров, А.К. Гутаковский, Т.С. Шамирзаев*. Энергетическое строение квантовых точек, сформированных в гетеросистеме InSb/AlAs
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

37. *О.А. Шегай, О.Р. Баятова, А.К. Бакаров*. Возникновение плато в фотопроводимости 2DEG AlGaAs/GaAs мезаструктур зигзагообразной формы
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

38. *Д. Мелебаев*. Фоточувствительность наноструктур Au-окисел- n -GaAs_{0.6}P_{0.4} в УФ области спектра
Институт солнечной энергии Академии Наук Туркменистана, Ашхабад

Фотодетекторы ближнего и дальнего ИК-диапазонов на основе соединений A_2B_6 и A_3B_5 , элементарных полупроводников и квантовых наноструктур (сверхрешетки, квантовые ямы, квантовые проволоки, квантовые точки)

39. *И.И. Ли, И.В. Мжельский, В.Г. Половинкин*. Об оптимизации конструктивных параметров ИК микроскопа
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

40. *Д.В. Марин, М.В. Якушев*. О путях снижения плотности V-дефектов в гетероструктурах $Cd_xHg_{1-x}Te$ выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках из Si(310)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

41. *А.П. Ковчавцев, А.А. Гузев, Д.В. Марин, А.В. Царенко, М.В. Якушев*. Пассивация поверхности HgCdTe тонкими слоями CdTe
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

42. *Д.В. Бородин², Д.В. Брунев¹, В.С. Варавин¹, В.В. Васильев¹, А.В. Вишняков¹, С.А. Дворецкий¹, А.В. Предеин¹, И.В. Сабина¹, Г.Ю. Сидоров¹, А.О. Сусяков¹, М.В. Якушев¹*. Сверхдлинноволновые линейчатые фотоприемники для дистанционного зондирования Земли.

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

²ООО "РТК Интекс", Мытищи

43. А. К. Бакаров, Н.А. Валишева, К. С. Журавлев, А.П. Ковчавцев, А.Е. Настовьяк, А. И. Торопов, А.В. Царенко. Характеристика слоев InAlSb для ИК фотоприемников, полученных методом МЛЭ
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

44. I. Yahniiuk¹, G. Grabecki², M. Majewicz², J. Wróbel², T. Dietl², G. Cywiński¹, C. Skierbiszewski¹, S.S. Krishtopenko³, S.A. Dvoretzky⁵, N.N. Mikhailov⁵, F. Teppé⁴, W. Knap^{1,4}. Pressure-driven transition from topological insulator into band insulator phase in HgTe quantum well
¹Institute of High Pressure Physics PAS, 29/37 Sokołowska, Warsaw, Poland

²Institute of Physics PAS, al. Lotników, Warsaw, Poland

³Institute for Physics of Microstructures RAS, GSP-105, 603950, N.Novgorod, Russia

⁴Laboratory Charles Coulomb, Montpellier University & CNRS, Montpellier, France

⁵Rzhanov Institute of Semiconductor Physics SB of RAS, 630090 Novosibirsk, Russia

45. А.В. Войцеховский^{1,2}, С.Н. Несмелов^{1,2}, С.М. Дзядух^{1,2}, В.С. Варавин³, С.А. Дворецкий^{1,3}, Н.Н. Михайлов³, М.В. Якушев³, Ю.Г. Сидоров³, Г.Ю. Сидоров³. Адмиттанс структур металл-диэлектрик-полупроводник на основе HgCdTe с приповерхностными широкозонными слоями, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии
¹Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

²Сибирский физико-технический институт НИ ТГУ, Томск

³Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

46. Н.М. Куляхтина^{1,2}, А.В. Никонов^{1,2}, К.О. Болтарь^{1,2}, Н.И. Яковлева¹. Исследование оптических характеристик эпитаксиальных слоёв InGaAsP

¹МФТИ (ГУ), Долгопрудный

²АО "НПО "Орион", Москва

47. А.В. Никонов^{1,2}, К.О. Болтарь^{1,2}, И.Д. Бурлаков^{1,3}, Н.И. Яковлева¹. Исследование спектральных характеристик многослойных гетероэпитаксиальных структур ИК- и УФ-диапазонов

¹АО "НПО "Орион", Москва

²МФТИ (ГУ), Долгопрудный, МО

³МГТУ МИРЭА, Москва

48. Г.Ю. Сидоров, И.В. Сабинина, В.В. Васильев, А.П. Ковчавцев, А.Е. Настовьяк, А.В. Царенко. Пассивация поверхности HgCdTe тонкими пленками Al₂O₃ полученными методом атомно-слоевого осаждения из ТМА

Институт физики полупроводников СО РАН им. А.В.Ржанова, Новосибирск

49. Н.Х. Талипов¹, А.В. Войцеховский². Оптимизация технологии формирования многоэлементных матричных ИК-фотоприемников на основе МЛЭ слоев Cd_xHg_{1-x}Te

¹Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино

²Томский государственный университет, Томск

50. М.О. Петрушков, Е.А. Емельянов, М.А. Путьято, Б.Р. Семягин, Н.А. Паханов, О.П. Пчеляков, В.В. Преображенский. Выращивание гетероструктур A_{III}B_V на подложках кремния методом МЛЭ для фотоэлектрических преобразователей

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

51. А.В. Шевлягин¹, НГ. Галкин¹, Д.Л. Горошко¹, А.К. Гутаковский². Кремний-силицидные нанокompозитные фотодетекторы ближнего инфракрасного диапазона

¹Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток

²Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

52. П.П. Добровольский, Л.С. Марченко, П.А. Алдохин. Исследования поглощающих покрытий холодных диафрагм в фотоприёмных устройствах ИК диапазона

Филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск

Физические основы элементной базы радиофотоники

53. **Е.А. Колосовский**. Анализ тонких оптических эффектов с помощью метода линий для интерферометра Маха-Цендера на основе Y-разветвителей

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

54. **А.А. Лямкина, С.П. Мощенко**. Влияние формы металлической частицы на экситон-плазмонное взаимодействие с точечным диполем

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

55. **А.Э. Симанчук¹, С.Н. Атутов¹, Н.А. Валишева², С.Л. Микерин¹, А.И. Плеханов¹, В.А. Сорокин¹, А.В. Якиманский³**. Нелинейно-оптические свойства хромофорсодержащих полиимидов и электрооптические устройства на их основе

¹*Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск*

²*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

³*Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург*

56. **И.О. Парм, А.В. Предеин, В.С. Варавин, В.В. Васильев**. Плазмохимический оксинитрид в реакторе с плазмой индукционного типа для пассивации гетероэпитаксиальных структур КРТ выращенных методом МЛЭ

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

57. **Р.М. Тазиев¹, И.В. Юнусов²**. Численное исследование полимерного электрооптического модулятора на микрополосковой линии

¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

²*ЗАО "НПФ "Микрон", Томск*

58. **М.Ю. Барабаненков^{1,2}, А.Г. Итальянцев²**. Узкополосные спектральные фильтры на основе нитяных дифракционных решеток и фотонных структур

¹*ИПТМ РАН, Черноголовка*

²*ОАО "НИИМЭ и Микрон", Москва, Зеленоград*

59. **М.Ю. Барабаненков^{1,2}, А.Г. Итальянцев²**. Магнитный отклик кластера немагнитных наночастиц при рассеянии электромагнитного излучения

¹*ИПТМ РАН, Черноголовка*

²*ОАО "НИИМЭ и Микрон", Москва, Зеленоград*

Полупроводниковые излучатели ближнего и дальнего ИК-диапазонов

60. **И.В. Осинных^{1,2}, Т.В. Малин¹, В.Ф. Плюснин^{2,3}, К.С. Журавлев^{1,2}**. Исследование зеленой полосы в спектрах фотолюминесценции сильно легированных слоев AlGaIn:Si с молярной долей Al выше 0.5

¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск*

³*Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского, Новосибирск*

61. **Г.М. Борисов^{1,2}, В.Г. Гольдорт¹, Д.В. Ледовских¹, А.А. Ковалёв¹, М.Н. Путьто¹, В.В. Преображенский¹, Н.Н. Рубцова¹, Б. Р. Семягин¹**. Кинетика релаксации полупроводниковых наноструктур A₃B₅, предназначенных для пассивной синхронизации мод лазеров

¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

²*Новосибирский государственный университет, Новосибирск*

62. **К.В. Феклистов, Д.С. Абрамкин**. Фотолюминесценция эрбия в Ta₂O₅. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

63. **М.Г. Нонне**, О моделировании естественной ширины линий в полупроводниковых лазерах

Новосибирский Государственный Технический университет

64. **А.А. Андронов, Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков¹; Д.Е. Святошенко, А.В. Маругин², В.С. Варавин, Н.Н. Михайлов³, С.А. Дворецкий³**. Стимулированное излучение и вертикально излучающие лазеры на двойных гетероструктурах кадмий-ртуть теллур с оптической накачкой на длине волны около 1 микрона

¹*ИФМ РАН, Н.Новгород*

²*ННГУ, Н.Новгород*

³*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

Приборы ночного видения: принципы построения, фотоэлектрические характеристики

65. **Д.В. Горшков**^{1,2}, **Н.И. Беспалко**³, **Д.В. Горшков**³, **М.В. Лобкин**³, **С.А. Кесаев**³, **С.Н. Косолобов**¹, **С.А. Рожков**^{1,2}, **Г.Э. Шайблер**¹, **А.С. Терехов**¹, Вклад фотоэлектронных явлений в р-GaAs (Cs,O) - фотокатоде и в промежутке фотокатод - МКП в частотно-контрастную характеристику планарного ЭОП

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

²НГУ, Новосибирск

³ОАО "Катод", Новосибирск

66. **Д.В. Бородин**, **Ю.В. Осипов**, **В.В. Васильев**, 3D фотоматрица видимого диапазона для регистрации быстрых процессов ООО "РТК Интекс", Мытищи

67. **Д.В. Бородин**, **Ю.В. Осипов**, **В.В. Васильев**, КМОП мультиплексоры форматов 6×576, 3×4×576, 64×64, 1×64 для гибридных ИК ФПУ ООО "РТК Интекс", Мытищи

68. **Д.В. Бородин**, **Ю.В. Осипов**, **Т.И. Анисимова**, **Д.С. Ельников**, **Е.В. Костюков**, **А.М. Маклаков**, **В.Ю. Ноженко**, **А.А. Пугачёв**, **Н.И. Рощина**, **А.С. Скрылёв**, **С.В. Трунов**, **Ю.М. Череманский**, Отечественные КМОП фотоприемники 4/3" и 1/3".

ОАО "НПП "Пульсар", Москва

69. **Д.В. Бородин**, **Ю.В. Осипов**, Отечественный КМОП фотоприемник 4/3", 1Мп при малых временах интегрирования и при больших освещенностях.

ОАО "НПП "Пульсар", Москва

70. **М.А. Демьяненко**, **Д.Г. Есаев**, **А.И. Козлов**, **В.Н. Овсяк**, Кремниевые мультиплексоры фотосигналов инфракрасных фотоприемников для гражданских применений

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

71. **М.А. Демьяненко**, **А.И. Козлов**, **В.Н. Овсяк**, Влияние параметров кремниевой схемы считывания фотосигналов и матрицы детекторов инфракрасного диапазона на характеристики фотоприемников
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

72. **И.Б. Чистохин**¹, **Н.А. Валишева**¹, **В.В. Преображенский**¹, **А.С. Скрылёв**², **В.В. Чернокожин**², **М.М. Крымко**², **Ю.В. Брашеван**², **Ю.И. Завадский**², Характеризация элементов матричного фотоприёмника на основе гетероструктур InP/InGaAs

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

²ОАО "НПП "Пульсар", Москва

73. **С.А. Кузнецов**^{1,2,3}, **А.Г. Паулиш**², Ультратонкие резонансные поглотители для болометрических детекторов субмиллиметрового диапазона

¹Новосибирский государственный университет, Новосибирск

²Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

³Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск

74. **С.А. Кузнецов**, Микроструктурные квазиоптические селективные элементы для диапазонов миллиметровых и терагерцовых волн
Новосибирский государственный университет, Новосибирск

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск

75. **С.В. Рыхлицкий**, **С.А. Дулин**, **В.Ю. Прокопьев**, **Е.К. Иванов**, **Н.А. Аульченко**, **Н.И. Назаров**, Технологический контроль оптических материалов фотоники по параметру объёмного рассеяния

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

76. **В.В. Карпов**¹, **В.П. Астахов**¹, **М.Е. Козырев**¹, **В.Ф. Чишко**¹, **В.И. Петренко**¹, **В.И. Семенов**¹, **Я.В. Гицилевич**¹, **Д.В. Бородин**², **Ю.В. Осипов**², **В.В. Васильев**², Быстродействующее малоформатное ФПУ 64×64 элементов на основе антимонида индия

¹ОАО "Швабе-Фотосистемы", Москва,

²ОАО "РТК Интекс" МО, Мытищи

Новые направления в создании тепловизионных приборов, многоспектральные и комплексные устройства ночного видения

77. **Д.В. Алантьев**, **С.В. Хрящев**, Результаты экспериментального исследования электроуправляемого широкоспектрального объектива с жидкостными линзами

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

78. **Б.Г. Вайнер**, Коротковолновые спектрально-узкополосные тепловизионные приемники ИК излучения в физических исследованиях

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

НГУ, Новосибирск

79. **А.В. Голицын**¹, **В.В. Шелковников**², Исследования жидкостной оптики

¹*Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск*

²*НИОХ СО РАН, Новосибирск*

80. **А.В. Голицын**, **Н.А. Сейфи**, Численная оценка дисперсии "идеального" жидкостного оптического материала для устранения хроматизма положения

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

81. **С.М. Борзов**¹, **А.В. Голицын**², **М.Ю. Цивинский**², Перспективы использования электроуправляемых жидкостных линз в оптико-электронных системах

¹*ИАиЭ СО РАН, Новосибирск*

²*Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск*

82. **А.А. Голицын**, Реализация алгоритма кусочно-линейного изменения контрастности изображения в приборах наблюдения

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

83. **С.А. Дворецкий**, **А.В. Зверев**, **Ю.С. Макаров**, **Е.А. Михантьев**, Быстродействующая малопотребляющая кремниевая интегральная схема считывания формата 384×288 для матричных ИК фотоприемников средневолнового и длинноволнового диапазонов

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

84. **Г.Е. Журов**, **М.Ю. Цивинский**, Малопотребляющий высокоскоростной модуль Ethernet 1G для многоканальных оптико-электронных приборов

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

85. **М.Ю. Цивинский**, Исследование и реализация алгоритмов автофокусировки для видимого и теплового спектральных диапазонов

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

86. **И.В. Мажельский**¹, **В.М. Базовкин**¹, **В.Г. Половинкин**^{1,2}, Сканирующий инфракрасный микроскоп с высоким пространственным разрешением

¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

²*НГТУ, Новосибирск*

87. **С.В. Мутилил**¹, **Л.В. Яковкина**², **Н.Д. Волчок**², **А.Ф. Булдыгин**¹, **В.Я. Принц**¹, Формирование и исследование свободных пленок VO₂, предназначенных для ИК и терагерцовых фотоприемников

¹*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

²*ИНХ СО РАН, Новосибирск*

88. **Г.Г. Горбунов**¹, **К.Н. Чиков**², **В.Б. Шлишевский**³, Гипер- и ультраспектральная видеоспектрометрия: методические и технические аспекты

¹*Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова, Санкт-Петербург*

²*Университет ИТМО, Санкт-Петербург*

³*Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск*

89. **Э.Г. Косцов**, **В.С. Соболев**, Быстродействующий неохлаждаемый тепловой приемник излучения на основе тонких пироэлектрических пленок

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск

90. **С.А. Кузнецов**^{1,2,3}, **С.Н. Макаров**¹, **В.Н. Кошеленко**¹, **А.В. Аржанников**¹, Визуализация и дистанционное зондирование объектов в диапазоне миллиметровых волн с использованием техники ЛЧМ-радаров

¹*Новосибирский государственный университет, Новосибирск*

²*Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск*

³*Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск*

91. **С.А. Кузнецов**^{1,2,3}, **М.А. Астафьев**¹, **А.В. Генцелев**³, **С.Г. Баев**⁴,
Фильтры высоких частот и плоские фокусаторы субмиллиметрового
диапазона на основе LIGA-структур

¹Новосибирский государственный университет, Новосибирск

²Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

³Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новоси-
бирск,

⁴Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск

92. **С.А. Кузнецов**^{1,2,3}, **М.А. Астафьев**¹, Фокусировка субмиллимет-
рового излучения в сложные области посредством субволновых
голографических структур

¹Новосибирский государственный университет, Новосибирск

²Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

³Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск

93. **В.В. Карпов**, **А.В. Мартиросов**, **В.И. Петренко**, **В.И. Семенов**,
К.В. Чиж, Стенд измерения фотоэлектрических параметров мат-
ричных фотоприемных устройств

ОАО "Швабе-Фотосистемы", Москва

94. **И.И. Ли**¹, **Н.В. Гришанов**², Цифровой кремниевый мультиплек-
сор для многоэлементных ИК ФПУ коротковолнового диапазона

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск

²Новосибирский Государственный технический университет,
Новосибирск

95. **В.Г. Половинкин**^{1,2}, **А.П. Ковчавцев**¹, **А.В. Царенко**¹, **А.Е. Нас-
товьяк**¹, Точно решаемая квантовая модель ОПЗ полупроводника

¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск

²НГТУ, Новосибирск